

نمونه ای از ترجمه مقاله :

## مدل سازی نویز ترانزیستور HEMT

با استفاده از تابع پایه شعاعی تعمیم یافته

HEMT Transistor Noise Modeling using Generalized Radial  
Basis Function

Mohsen Hayati , Ali Shamkhani , Abbas Rezaei , Majid Seifi  
Electrical Engineering Department  
Faculty of Engineering, Razi University  
Tagh-E-Bostan, Kermanshah-67149, Iran  
0098918812041(PHONE), 00988324274542(Fax),  
mohsen\_hayati@yahoo.com , ali.shamkhani@yahoo.com, arezaei818@yahoo.com ,  
majidsfy@gmail.com

ICSE 2008 Proc. 2008, Johor Bahru, Malaysia

برای خرید ترجمه فارسی این مقاله (با فرمت ورد) همراه با  
مقاله انگلیسی **اینجا** کلیک نمایید.

فروشگاه اینترنتی ایران عرضه

برای تحلیل و طراحی مدارهای فعالی میکروویو که جزئی از سیستم های ارتباط مدرن محسوب می شوند به مدل های نویز معتبر و درست ترانزیستورهای میکروویو نیاز می باشد، در این وضعیت پائین نگه داشته شدن نویز در سطح پائین از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. ارائه و توسعه مدل اساساً یک فرایند بهینه سازی تلقی شده و به همین خاطر وقت گیر می باشد. به علاوه، برای ارائه مدل که به وقت و تلاش بیشتری نیاز دارد، به داده های مربوط به نویز و سیگنال اندازه گیری شده برای هر نقطه عملیاتی جدید نیاز می باشد، زیرا این قبیل اندازه گیریها نیازمند تجهیزات و روشهای پیچیده ای می باشند .

## I. INTRODUCTION

Accurate and reliable noise models of microwave transistors are necessary for analyses and design of microwave active circuits that are parts of modern communication systems, where it is very important to keep the noise at a low level. Model development is basically an optimization process and can be time-consuming. Furthermore, measured signal and noise data for each new operating point are necessary for model development, which could take much effort and time, since these measurements require complex equipment and procedures [1, 2].

برای خرید ترجمه فارسی این مقاله (با فرمت ورد) همراه با مقاله انگلیسی **اینجا** کلیک نمایید.

iran arze.ir

مرجع مقالات ترجمه شده